# 講座 高速プラズマ流と衝撃波の研究事始め

# 1. プラズマ衝撃波の基礎物理

# 1.5 静電波ソリトンと無衝突衝撃波の基礎実験

佐伯紘一 静岡大学理学部 (原稿受付:2006年11月7日)

典型的な非線形局所構造である静電波ソリトンや無衝突静電衝撃波が存在することを,波数-位相速度ダイ アグラムや擬似ポテンシャル (Sagdeev's Potential)を用いて説明する.その具体例として、イオン音波ソリトン や、イオンの反射などを伴うイオン音波衝撃波の実験を提示する.さらに強い衝撃波として、ビーム衝撃波が存 在することを実験結果により示す.次に、磁化円筒プラズマ中の電子プラズマ振動数の領域における電子プラズ マ波衝撃波の実験を紹介する.最後に、高周波電場を駆動力とするイオン音波衝撃波が存在することを示す.

#### Keywords:

electrostatic soliton, collisionless shock wave, wave number-phase velocity diagram, ion acoustic wave shock, reflected ions, beam shock wave, electron plasma wave shock, high frequency electric field driven ion acoustic shock

## 1.5.1 はじめに

前章において,磁気音波,磁気音波衝撃波が論じられた. ここでは,まず静電波ソリトンおよび静電衝撃波について 述べる[1].典型的な非線形局所構造である静電波ソリト ン,およびその変形である無衝突衝撃波が存在することを 示す.続いて,実験で観測されたイオン音波ソリトンの特 徴的な性質や,イオンの反射を伴うイオン音波衝撃波の詳 細を提示する.さらに強い衝撃波として,ビーム衝撃波が 存在し,円筒磁化プラズマ中の電子プラズマ波領域で励起 される電子プラズマ波衝撃波の実験結果を示す.また,高 周波電場駆動イオン音波衝撃波について述べる.

### 1.5.2 波数-位相速度ダイアグラムと静電非線形 局所解

まず,磁化されていない一次元プラズマにおける静電非 線形局所解について考察する.静電非線形局所解の存在領 域を判定するためには,波数-位相速度ダイアグラムを活 用するとわかりやすい[2].磁化されていない一次元プラ ズマの分散式は,

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \left( 1 - \frac{\omega_{\rm pe}^2}{k^2 (u^2 - \gamma_{\rm e} v_{\rm te}^2)} - \frac{\omega_{\rm pi}^2}{k^2 (u^2 - \gamma_{\rm i} v_{\rm ti}^2)} \right) = 0. \quad (1)$$

のように書ける. ここで,  $\epsilon$ ,  $\omega_{pe}$ ,  $\omega_{pi}$  は, それぞれ, プラ ズマ誘電率,電子, イオンプラズマ角周波数である.  $v_{ti}$ ,  $v_{te}$  は,電子, イオン熱速度である. u, k は, 波の位相速度 と波数である.  $\gamma_{e}$ ,  $\gamma_{i}$  は.電子およびイオンの比熱比であ る.ここで,  $\gamma_{e,i}$ は $u \gg v_{te,ti}$ の時, 3 であり,  $u \ll v_{te,ti}$ の時, 1 である.

上式より計算して得られる, 波数 k と位相速度 u の間の

関係を表した,波数-位相速度ダイアグラムを図1に示す. ここで位相速度uは実数であるとしている. $c_s$ , $k_{De}$ , $k_{Di}$ は、イオン音波速度、電子、イオンのデバイ長の逆数である. $u > \sqrt{3}v_{te} \ge c_s > u > \sqrt{3}v_{ti}$ は、波動伝播領域であり、それぞれ実数の波数 $\pm k_r$ を持つ電子プラズマ波とイオン音波の波動解が得られる.

次に、虚数の波数  $\pm k_i$  を持つ非波動伝播領域について説明する.この領域においては、図 2a)に示すように、実数の位相速度 u に対して、純虚数の波数  $\pm k_i$  の解を持つ.したがって、指数関数的に ( $-\exp(k_ix)$ ) 電位変動が立ち上がった後、指数関数的に ( $-\exp(-k_ix)$ ) 電位変動が減衰するような波形を持ち、位相速度 u で伝播する非線形局所解が得られる可能性があることを示唆している.振幅が大きくなると非線形性を考慮する必要がある.しかしながら、非線形局所構造の尾部の波形は、線形理論で記述される.

実際に、図1で示された、虚数の波数±k<sub>i</sub>を持つ非波動 伝播領域において、図2a)に示すような、非線形性を考慮 した擬似ポテンシャル (Sagdeev's Potential)を導くことに より、典型的な非線形局所解が存在することを示すことが できる.具体的には u > c<sub>s</sub>の領域で、イオン音波ソリトン の存在を示すことができる.この場合、次節で述べるよう にイオン音波ソリトンの半値幅Dは虚数の波数k<sub>i</sub>で決定さ れる.したがって、u > c<sub>s</sub>の領域における波数・位相速度 ダイアグラムは、イオン音波ソリトンの半値幅Dと、非線 形局所構造の伝播速度uの関係を示していることにな る.さらにイオンの反射などを考慮すればイオン音波衝撃 波やビーム衝撃波が励起できることを示すことができる. また、図1には、円筒磁化プラズマ中における電子プラ

ズマ波領域の波数-位相速度ダイアグラムをも合わせて示

1. Physics of Plasma Shock Waves 1.5 Verification of Electrostatic Solitons and Shock Waves SAEKI Koichi

author's e-mail: spksaek@ipc.shizuoka.ac.jp



図1 波数-位相速度ダイアグラム.実線、点線はそれぞれ磁場のない1次元プラズマにおける波数の実部 kr,波数の虚部 kiである.1点鎖線、2点鎖線は、それぞれ円筒磁化プラズマ中を磁場方向に伝播する電子プラズマ波の領域における波数の実部 kr,波数の虚部 kiである.



図 2 擬似ポテンシャル V(φ)と、V(φ)より得られる非線形局所
 解. M > 1. a) イオン音波ソリトン、b) イオン音波衝撃波、
 c) イオンビーム衝撃波.

している.すなわち,円筒半径で決まる磁場に垂直方向の 波数 $k_{\perp}$ が有限であれば,イオン音波衝撃波と同様の議論に より,電子プラズマ波衝撃波が存在することになる.さら に,擬似ポテンシャルを用いれば,イオン位相空間ホール が領域 $u < \sqrt{3}v_{ti}$ に[3],イオンシースが 領域 $u > c_s$ に,電 子位相空間ホールが領域 $u < \sqrt{3}v_{te}$  に[4],結合ホールソリ トン(結合電子ホールイオン音波ソリトン)が領域  $\sqrt{3}v_{te} > u > c_s$ に存在することを示すことができる[5].

#### 1.5.3 イオン音波ソリトン

前節で,領域 *u* > *c*s において定常イオン音波ソリトン解 が存在する可能性について述べた.このことを,定常解を 記述する擬似ポテンシャルを用いて示す.定常イオン音波 ソリトンを記述するには,ポアソンの式に,定常状態にお けるエネルギー保存則,流束一定の式,電子に関するボル ツマン関係式を代入すればよい.この結果,以下のような 擬似運動方程式,および擬似ポテンシャル*V*(*φ*)が得られ る.

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = -\frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi}, \qquad (2)$$

$$V(\phi) = \left(\frac{k_{\rm B} T_{\rm e}}{e \lambda_{\rm De}}\right)^2 \left[1 - \exp\left(\frac{e\phi}{k_{\rm B} T_{\rm e}}\right) + M^2 \left\{1 - \left(1 - \frac{2e\phi}{k_{\rm B} T_{\rm e} M^2}\right)^{1/2}\right\}\right]. (3)$$

ここで、マッハ数  $M = u/c_s$  である. 1 < M の場合の擬似ポ テンシャル  $V(\phi)$  を、図 2 a) に示す. 擬似運動方程式にお いて、x を時間、 $\phi$  を位置とし、擬似ポテンシャル  $V(\phi)$ 中を運動する粒子を想定すれば、 $V(\phi)$  より、イオン温度が 零 の 場 合 の イオン 音 波 ソリトン の 解 が 得 ら れ る. 1 < M < 1.6 の範囲で正電位のイオン音波ソリトンが存在 する. この時、密度変動も正である.マッハ数に最大値が 存在する理由は、マッハ数とともに電位振幅は増し、つい には静止イオンが反射され、解が存在しなくなるためであ る.得られるソリトン解は、イオン温度が零の場合の厳密 な解である.擬似ポテンシャル $V(\phi)$  を電位 $\phi$ について展開 し 3 次の項まで考慮した場合、ソリトン解は、以下のよう になる.

$$\phi = \phi_{\max} \operatorname{sech}^2\left(\frac{x - ut}{D}\right),\tag{4}$$

$$M - 1 = \frac{2}{k_{\rm De}^2 D^2} = \frac{e\phi_{\rm max}}{3k_{\rm B}T_{\rm e}} = \frac{\tilde{n}_{\rm max}}{3n_0}.$$
 (5)

で与えられる.ここで、 $\phi_{max}$ 、 $\hat{n}_{max}$ 、Dは、それぞれイオ ン音波ソリトンの電位振幅、密度振幅、半値幅である.ま た、x、 $k_{\rm B}$ 、 $T_{\rm e}$ はそれぞれ、ソリトンの伝播距離、ボルツマ ン定数、電子温度である.したがって、ソリトンの半値幅 Dと伝播速度uの関係は、

$$\frac{2}{D} = k_{\rm De} \sqrt{2(M-1)}.$$
 (6)

となる.一方,分散式(1)より,ソリトンの尾部における 純虚数の波数 $k_i$ と伝播速度uの関係は,図1に示すように,

$$k_{\rm i} = \sqrt{k_{\rm De}^2 - \omega_{\rm pi}^2 / u^2} \simeq k_{\rm De} \sqrt{2(M-1)}, \qquad (7)$$

となる.結局,電位  $\phi$  について 3 次の項まで考慮した場合 のイオン音波ソリトンの半値幅 D は,波数 - 位相速度ダイ アグラムの領域 $u > c_s$ における純虚数の波数 $k_i$ により決定 されることになる.

擬似ポテンシャル $V(\phi)$ を電位 $\phi$ について3次の項まで 考慮した場合のソリトン解のダイナミックスは,以下の KdV 方程式で記述される[6].

$$\frac{\partial \phi}{\partial \tau} + c_{\rm s} \frac{e\phi}{kT_{\rm e}} \frac{\partial \phi}{\partial \xi} + \frac{\lambda_{\rm De}^2 c_s}{2} \frac{\partial^3 \phi}{\partial \xi^3} = 0.$$
 (8)

$$\xi = \varepsilon^{1/2} \left( x - c_s t \right), \qquad \tau = \varepsilon^{3/2} t. \tag{9}$$

KdV 方程式についての1.4.2節の議論からわかるように, 式の第2項による突っ立ち効果と第3項による分散効果の 釣り合いによりイオン音波ソリトン解が得られる.

イオン音波ソリトンの実験は[7,8],池地らによりダブ ルプラズマ装置を用いて行われた.ダブルプラズマ装置 は、負電位のグリッドで2つのプラズマ間の電子による導 通を制限した状態で、ドライバープラズマに正の電圧を加 えることにより、ドライバープラズマのイオンをターゲッ トプラズマ中に注入し、大振幅イオン音波、ソリトン、衝 撃波を励起する装置である.したがってターゲットとする プラズマ中に注入するイオンの密度と速度を独立に制御で きる.

約1Vの正のパルス電圧を印加しイオンを注入した時の 結果を、図3に示す.プラズマはアルゴンプラズマであり、 密度は約10<sup>9</sup> cm<sup>-3</sup>、電子温度 $T_e$ は1.5-3 eV、イオン温度  $T_i$ は0.2 eVである.ターゲットプラズマより注入したイオ ンは、プラズマ中に強い密度変動パルスを引き起こす.こ の結果、強い密度変動パルスの前面では、突っ立ち効果が 現れ、後面では分散効果により細かく密度が変動するよう になる.結果的に密度変動パルスは、突っ立ち効果と分散 効果が釣り合ったイオン音波ソリトンの列を次第に形成し ていく様子を見事に捉えている.各々のソリトンの半値幅 D、伝播速度uはほぼ理論に従い、図4に示すように振幅  $\delta n/n_0$ の大きいほど速く伝播し、かつ半値幅は狭くなる. ファラデーカップを用いたイオン速度分布の測定結果から、密度変動パルスの前の前駆信号は、一部は最前列のソ リトンによる反射イオンであり、一部はドライバープラズ マからの注入イオンである、ソリトンの形成には温度比 *T<sub>e</sub>*/*T<sub>i</sub>*が重要であり、この値が10以下であるか、たとえば水 素のような軽いイオンが多少存在すれば、密度変動パルス はソリトンに分裂せず乱流ノイズを誘起する。このような 条件が除外されれば、密度変動パルスがソリトン列に分裂 する時のソリトンの数は、密度変動パルスのパルス電圧の 1/2 乗と、パルス幅に比例して増大し、最大7個に分裂し た.また、大振幅イオン音波を励起したところ、2つ程度 のソリトンに分裂し、それぞれのソリトンの伝播速度の違 いにより、再び元の大振幅イオン音波に再帰する興味ある 現象も観測された.

#### 1.5.4 イオン音波衝撃波

イオン音波ソリトンは、前節で述べたようにイオン温度 が有限であればソリトン前面においてイオンを反射してい る. この反射量が少なければソリトンは減衰しにくいが、 ソリトンの振幅が大きくなれば必然的に反射量が増大する ため、ソリトンは減衰せざるを得ない. このような状況下 において定常状態を維持しようとするためには、常に後方 から減衰を補うだけのエネルギーが注入できる衝撃波タイ プの解を想定しなければならない. したがって、擬似ポテ ンシャル  $V(\phi)$ を表す式(3)に反射イオンの効果を取り入 れなければならない. これは非対称な現象であるから、図 **2**の a)の対称な電位 $\phi$  は、b)のように前面で $\phi_{I}$ ,後面で  $\phi_{II}$ であるような非対称な電位を持つように変化する. 文献 [1]の計算結果によれば、衝撃波の前面でイオンを定常に



opered and





図 4 a) イオン音波ソリトンの半値幅 D と, b) 伝播速度 u のソ リトン振幅依存性 (after lkezi *et al.* [7]).

反射し続けるためには、衝撃波の後部で電位が高くなる図 **2**の b)のような擬似ポテンシャル $V(\phi_{I})$ ,  $V(\phi_{II})$  を持つ必 要があることが示されている.この結果、衝撃波前面で単 調に変化し、後面で調和振動する波列を持つ衝撃波解が得 られる.現実には、後面の波列は、図**2**の b)のように波と 粒子との相互作用と思われる損失により減衰する.

イオン音波衝撃波の実験も,ダブルプラズマ装置を用い て、ドライバープラズマに図5に示すような正のランプ電 圧を加え、ドライバープラズマ中のイオンをターゲットプ ラズマに注入することにより行われた[9]. 図から明らか なように衝撃波の前面で突っ立ちが起き,後面には減衰す る波列を持つ衝撃波が形成されることがわかる. この時, 同時に衝撃波前面に反射イオンなどを含む前駆信号が存在 している.衝撃波の形状の衝撃波振幅依存性を図6に示 す.振幅が増すに従い,伝播速度が増すと同時に,衝撃波



Time  $5 \,\mu s$ /division

図5 大振幅イオン音波の突っ立ちとイオン音波衝撃波の形成 (after Taylor *et al.*[9]).



図6 イオン音波衝撃波の振幅依存性 (after Taylor et al. [9]).

前面の幅が狭くなる.また,衝撃波後面の波列の波長は振幅が大きくなるに従い短くなり,かつ強く減衰するようになる.衝撃波前面には反射イオンも存在している.これらの図から明らかなように,無衝突イオン音波衝撃波はイオン音波ソリトンと強く関係しており,イオン音波ソリトンの一部の性質を保持しながら,無衝突プラズマにおけるエネルギー損失機構であるイオンの反射や波と粒子との相互作用などの効果を補うだけのエネルギーを後方より注入することにより衝撃波が維持されていると考えられる.

#### 1.5.5 イオンビーム衝撃波

イオン音波衝撃波の実験において、注入するイオンビー ムの速度を増大させると特異な波形が観測されることを示 したのが、図7b)である[10].通常のプラズマ密度の圧縮 によるイオン音波衝撃波の振る舞いは図7a)に示され, 突っ立ちや波列の形成が観測できる.しかし、図7b)にお いては注入するイオンビームの加速電圧をまず6Vとし, 次にt=0に加速電圧を急激に14Vに変化してイオンビー ムをさらに加速させた.この結果,50%以上の正の密度変 動を持つ台形状のビーム非線形圧縮波が励起され、かつ台 形状の圧縮波の幅は伝播しながら広がっていくことがわか る.この圧縮波をイオンビーム衝撃波とよぶ.ここで背景 の静止イオン密度は非常に低い. 電子のボルツマン平衡則 よりイオンビーム衝撃波は正の電位を持つ. ビーム衝撃波 におけるイオンの位相空間分布(位置と速度空間上の分布) を観測したのが図8である.ただし、ここでは圧縮波の重 心は、一定の速度で伝播しているので位相空間分布を、時 間とエネルギー空間上のイオンの分布として観測してい る. ここでは、静止イオンと同程度の密度のイオンビーム をt=0に注入した.しかし図7b)と図8のビーム衝撃波 は本質的に同じ現象である.ここで、図8においては、 (E)はイオンビーム衝撃波の圧縮部のイオンを示す.また, 位相空間分布上のイオンは、(A)静止イオン、(B)注入イ オンビーム, (C) 正のイオンビーム衝撃波の右の衝撃波面 で反射された注入イオンの内の一部のイオンと静止イオ ン、(D)静止イオンの内の左の衝撃波面で反射されたイオ ンと注入イオンの内の右の衝撃波面、圧縮部、左の衝撃波 面を通過したイオンからなる.

この時の擬似ポテンシャルV(¢) を、図8におけるイオ ンビーム衝撃波の圧縮部(E)の重心を中心に左右に広がる 衝撃波であるとして静止イオン、注入イオンおよびそれら のイオンの一部でイオンビーム衝撃波の左と右の衝撃波面 で反射されたイオンを考慮することにより求めて図2c)に 示す[10].結局,圧縮部(E)の重心を中心に左右に広がる イオンビーム衝撃波解が求まり,実験結果をよく説明する ことができる.

#### 1.5.6 電子プラズマ波衝撃波

次に,円筒磁化プラズマ中を伝播する静電電子プラズマ 波に関係した衝撃波について述べる.この波はTrivelpiece -Gould Mode とよばれており,電子プラズマ波領域の分散 関係式は以下のように書ける.



図 7 a)弱いイオン音波衝撃波と,b)イオンビーム衝撃波の伝播 (after Ikezi *et al.* [10]).



図8 イオンビーム衝撃波における電子密度変動と、イオンの位 相空間分布.ただし、時間とエネルギー空間上のイオンの 分布を白いドットで示している (after lkezi *et al.* [10]).

$$k_{\perp}^{2} + k^{2} \left( 1 - \frac{\omega_{\rm pe}^{2}}{k^{2} (u^{2} - 3v_{\rm te}^{2})} \right) = 0.$$
 (10)

ここで,  $k_{\perp}$ は磁場に垂直方向の波数である.金属円筒プラ ズマの場合,通常,磁場に垂直方向に0次の第1種ベッセ ル関数で径方向に最低次のモードが励起される.この時,  $k_{\perp} = 2.4/a$ となる.ここで, aは,金属円筒の半径である. 波数-位相速度ダイアグラムを表す図1に,電子プラズマ 波領域における波数kと位相速度uの間の関係をも書き加 えた.ここで,1点鎖線,2点鎖線は,それぞれ位相速度 uが実数の時の波数の実部 $k_r$ と,波数の虚部 $k_i$ である.こ の時,この波は波数kの小さい時, $u = \omega_{pe}/k_{\perp}$ の一定速度で 伝播する.イオン音波の場合イオンの振動が電子により遮 蔵されることにより一定のイオン音波速度 $c_s$ で伝播するの に対して,円筒磁化プラズマにおいては電子の振動が金属 円筒により遮蔽されるため, $u = \omega_{pe}/k_{\perp}$ の一定速度で伝播 する.この波は、宇宙プラズマにおいては静電ウイスラー 波とよばれ、磁場に斜めに伝播する.したがって、この波 は静電ウイスラー波の導波管モードとみなすことができ る.

図1において,電子プラズマ波伝播速度 ω<sub>pe</sub>/k<sub>⊥</sub> 領域の波 数の振る舞いは,イオン音波速度 cs 領域の波数の振る舞い とよく似ている.図2a)のイオン音波ソリトンの場合と同 様に,擬似ポテンシャルを求めてみると電位 φ の負の領域 にソリトンが存在しうることを示すことができる.すなわ ち電子密度変動が正,電位変動が負の電子プラズマ波ソリ トンが存在する.比較的小振幅の場合の電子プラズマ波ソ リトンのダイナミックスを記述するKdV方程式は,以下の ように表される[13].

$$\frac{\partial \phi}{\partial \tau} - \frac{3\alpha}{2} \left( \frac{\omega_{\rm pe}}{k_{\perp}} \right) \left( \frac{e\phi}{m \left( \frac{\omega_{\rm pe}}{k_{\perp}} \right)^2} \right) \frac{\partial \phi}{\partial \xi} + \frac{1}{2k_{\perp}^2} \left( \frac{\omega_{\rm pe}}{k_{\perp}} \right) \frac{\partial^3 \phi}{\partial \xi^3} = 0.$$

$$\xi = \varepsilon^{1/2} \left( x - \left( \frac{\omega_{\rm pe}}{k_{\perp}} \right) t \right), \quad \tau = \varepsilon^{3/2} t, \quad \alpha = 0.72.$$
(12)

ここで、α は磁場に垂直方向のベッセル関数で表される電 位分布による非線形効果の補正項である.この方程式から も、イオン音波の場合と同様に、電位が負、密度変動が正 の電子プラズマ波ソリトンの存在が導ける.さらに、衝撃 波前面における電子の反射などを考慮すれば衝撃波解を得 ることができる.

電子プラズマ波領域における電子プラズマ波ソリトンや 電子プラズマ波衝撃波は、金属円筒プラズマの端にグリッ ド,電子ビーム源,金属円筒のいずれかを設置し,負電位 信号を印加することにより励起することができる. 用いた プラズマはQマシーンで生成したカリウムプラズマであ り, 密度は約10<sup>7</sup> cm<sup>-3</sup>, 電子温度 T<sub>e</sub> は 0.4 eV である.印加 した磁場B=0.2Tである.電子プラズマ波ソリトン [11]は、まずグリッドを用いて励起された、続いて電子プ ラズマ波衝撃波が、電子ビーム源および金属円筒を利用し てより効率的に励起された[12,13]. ここでは電子ビーム 源を用いることにより電子を注入して、大振幅電子プラズ マ波、電子プラズマ波衝撃波を励起した実験例を図9に示 す. 電子プラズマ波の場合, KdV 方程式の第2項の係数が 負であるために、図9a)のように負のランプ電圧を電子 ビーム源に印加し電子を注入すると,電位が負の方向に 突っ立ちを起こし負電位の衝撃波波面を形成していること がわかる.衝撃波後面には減衰する波列を持ち、この時、 同時に衝撃波前面に反射電子などを含む前駆信号が存在し ている.次に大振幅電子プラズマ波を励起し、その非線形 的振る舞いを観測したのが図9b)である.大振幅波は伝播 するに従い突っ立ちを起こし、かつ分散効果により波列が 生成されており、強い非線形性により高調波が励起されて いることが良くわかる.電子プラズマ波衝撃波の形状の衝 撃波振幅依存性を図10に示す.振幅の増大とともに、衝撃 波前面の幅が狭くなり、衝撃波後面の波列の波長は短く なっている. 衝撃波前面の反射電子などを含む前駆信号も 次第に大きくなっている. 電子プラズマ波の伝播速度



図 9 a)電子プラズマ波の突っ立ちと衝撃波の形成.b)大振幅電子プラズマ波における高調波の生成.(after Saeki *et al.* [13]).



図10 電子プラズマ波衝撃波の振幅依存性 (after Saeki *et al.* [12]).

 $u = \omega_{pe}/k_{\perp}$ と同じ速度でプラズマ中に電子ビームを注入す る時の印加ステップ電圧は14 Vである.この電圧より大き な負のステップ電圧を印加した時,衝撃波の後方に電位 ジャンプが観測できる.これは注入した電子ビームが電子 プラズマ波より速くなることによる電子ビーム衝撃波であ ると考えられる.この電位ジャンプは条件によっては不安 定となる.

#### 1.5.7 高周波電場駆動イオン音波衝撃波

最後に、高周波電場で駆動されるイオン音波衝撃波の実 験について述べる[14]. この実験においては、図11に示す ようにダブルプラズマ装置のドライバープラズマからター ゲットプラズマに打ち込まれイオンが自由イオン流となっ て広がっていく.この自由イオン流からなるプラズマに高 周波電場を加えることによって高周波電場で駆動されるイ オン音波衝撃波を励起している.図11a)は、自由イオン流 が電子により遮蔽されながら広がる様子をプラズマ密度の 時間・空間変化で表している.この時,自由イオン流のイ オンの速度は、イオン音波の速度より速い. このプラズマ 中のグリッドに 330 MHz の高周波電圧を加えると 図11 b)からわかるように、密度のジャンプが形成されイオン流 より遅い速度で伝播するようになる.この時加えた高周波 電圧の周波数は平均的な電子プラズマ振動数に等しくして ある.この密度のジャンプは、高周波電場を伴っているこ とが図11c)の電場の空間分布より理解できる. すなわち, 高周波電場を伴った密度の凹みが自由イオン流に乗ってみ ればイオン流と逆方向にイオン音波の速度で伝播すること が実験的に示された.これは高周波電場駆動イオン音波衝



図11 高周波電場駆動イオン音波衝撃波の形成.高周波電場が、
 a)ない時と、b)ある時の電子プラズマ密度分布.c)高周波電場の振幅分布.(after lkezi *et al.* [14]).

撃波とみなすことができる.この衝撃波を励起するための 高周波電圧のしきい値があり、電場によって振動する電子 の速度が、電子熱速度より大きくなったとき励起される. 実験データは、この衝撃波が電場と密度の波列を伴ってい ることをも示している.

#### 1.5.8 おわりに

まず,静電波ソリトンおよび静電波衝撃波の存在領域 が,その波の分散特性に強く依存しており,波数 - 位相速 度ダイアグラムにより明確に示せることを明らかにした. 続いて,擬似ポテンシャルにより,静電波ソリトンおよび 静電衝撃波の定常解を導き,さらに非線形KdV方程式を用 いて,実験で得られたイオン音波衝撃波,電子プラズマ波 衝撃波の非線形ダイナミックや,定常状態における性質を 明らかにした.衝撃波を形成するためには,衝撃波前面に おけるイオンの反射が重要であり,特にビーム衝撃波の場 合には,実験室から観測した場合,強いイオンの反射が衝 撃波の前面と後面に起こることを示した.さらに高周波電 場により衝撃波が駆動されることを実験結果により示し た.

#### 謝辞

ソリトンや衝撃波についてお教えいただいた池地先生, 討論していただいたデンマークリソー研究所プラズマ物理 グループ,院生として共同研究を行った源馬仁氏に感謝いたします.

### 参 考 文 献

- [1] D.A. Tidman and N.A. Krall, Shock Waves in Cllionless Plasmas (John Wiley & Sons, Inc., New York, 1971).
- [2] K. Saeki, J. Plasma Fusion Res. SERIES 4, 23 (2001).
- [3] H.L. Pécseli, R.J. Armstrong and J. Trulsen, Phys. Lett. 81A, 386 (1981).
- [4] K. Saeki, P. Michelsen, H.L. Pecseli and J.J. Rasmussen, Phys. Rev. Lett. 42, 501 (1979).
- [5] K. Saeki and H. Genma, Physical Review Letters, 80, 1224 (1998).
- [6] H. Washimi and T. Taniuchi, Phys. Rev. Lett. 17,996 (1966).
- [7] H. Ikezi, R.J. Taylor and D.R. Baker, Phys. Rev. Lett. 25, 11 (1970).
- [8] H. Ikezi, Phys. Fluids 16, 1668 (1973).
- [9] R.J. Taylor, D.R. Baker and H. Ikezi, Phys. Rev. Lett. 24, 206 (1970).
- [10] H. Ikezi, T. Kamimura, M. Kako and K.E. Lonngren, Phys. Fluids 16, 2167 (1973).
- [11] H. Ikezi, P.J. Barrett, R.B. White and A.Y. Wong, Phys. Fluids 14, 1997 (1971).
- [12] K. Saeki, and H. Ikezi, Phys. Rev. Lett. 29, 253 (1972).
- [13] K. Saeki, J. Phys. Soc. Japan 35, 251 (1973).
- [14] H. Ikezi, K. Mima, K. Nishikawa and M. Inutake, Phys. Rev. Lett. 36, 794 (1976).